

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-332323  
 (43)Date of publication of application : 30.11.2001

(51)Int.Cl.

H01R 11/01  
 G01R 1/06  
 G01R 1/073  
 G01R 31/26  
 H01L 21/66

(21)Application number : 2000-153199

(71)Applicant : ANRITSU CORP

(22)Date of filing : 24.05.2000

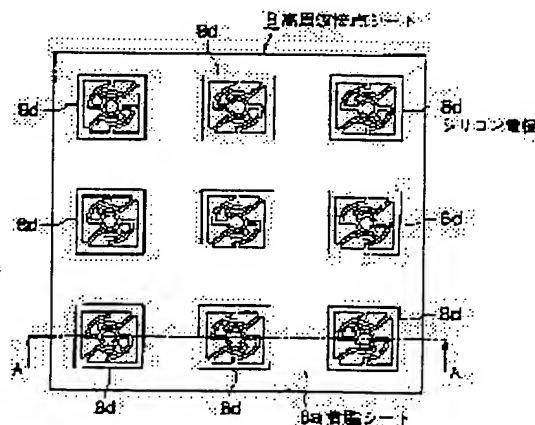
(72)Inventor : KOTADO SETSUO  
 TSUGANE HIRONORI  
 HAYAKAWA SATOSHI

(54) SILICON ELECTRODE AND HIGH FREQUENCY CONTACT POINT SHEET AS WELL AS MANUFACTURING METHOD OF SILICON ELECTRODE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high frequency contact point sheet to conduct a performance test of IC elements of ultrahigh frequency with high accuracy.

SOLUTION: The high frequency contact point sheet 8 is equipped with an insulation sheet 8a, a through hole 8b penetrating from a surface of one side through to the surface of the other side of the sheet 8a, plural silicon electrodes 8d which supports a central part 10 formed of a silicon plate and equipped with an electrode protruding part 8e on a surface of one side against an outer circumferential part 9 by at least one beam part 11, and which covers an opening of the through hole 8b, and in which the electrode protruding part 8e is equipped so as to be positioned in the opposite side of this through hole 8b, and an electro-conductive part 8c equipped at the side face of the through hole 8b in order to make an electric contact between the silicon electrodes 8d equipped in the state that they pinch the through hole 8.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 14.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2001-332323  
(P2001-332323A)

(43) 公開日 平成13年11月30日 (2001.11.30)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームコード (参考)
H 0 1 R 11/01		H 0 1 R 11/01	G 2 G 0 0 3
G 0 1 R 1/06		G 0 1 R 1/06	A 2 G 0 1 1
	1/073		F 4 M 1 0 6
	31/26		J
H 0 1 L 21/66		H 0 1 L 21/66	B
審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 9 頁)			

(21) 出願番号 特願2000-153199 (P2000-153199)

(22) 出願日 平成12年5月24日 (2000.5.24)

(71) 出願人 000000572

アンリツ株式会社

東京都港区南麻布5丁目10番27号

(72) 発明者 古田 士 節夫

東京都港区南麻布5丁目10番27号 アンリツ株式会社内

(72) 発明者 津金 浩典

東京都港区南麻布5丁目10番27号 アンリツ株式会社内

(74) 代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外 5 名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シリコン電極及び高周波接点シート並びにシリコン電極製造方法

(57) 【要約】

【課題】 超高周波の I C 素子の性能検査を高精度に行うための高周波接点シートを提供する。

【解決手段】 絶縁性のシート 8 a と、シート 8 a の一方の表面から他方の表面まで貫通したスルーホール 8 b と、シリコン板から形成され外周部 9 に対して一方の表面に電極突起部 8 e を備えた中心部 1 0 を少なくとも一つの梁部 1 1 で支持し、スルーホール 8 b の開口部を覆い電極突起部 8 e がこのスルーホール 8 b と反対側に位置するように備えられた複数のシリコン電極 8 d と、スルーホール 8 b を挟んだ状態で備えられているシリコン電極 8 d の間を電氣的に導通させるためにスルーホール 8 b の側面に備えられた導電部 8 c とを具備した高周波接点シート 8 を提供する。

